



⑪ 日本国特許庁(JP)

40特許出顧公開

[®]公開特許公報(A)

昭60-226125

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和60年(1985)11月11日

H 01 L 21/30

Z-6603-5F

客査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

❷発明の名称 レジスト膜の形成方法

②特 顧 昭59-84363

会出 顕 昭59(1984)4月25日

の発明者 大 熊の発明者 高 島

微片

門真市大字門真1005番地 松下電子工業株式会社內門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社內

⑪出 閱 人 松下電子工業株式会社

門真市大字門真1006番地

00代 理 人 弁理士 中尾 敏男

外1名

・1、発明の名称

レジスト膜の形成方法

- 2、特許請求の範囲
- (1) ホトレジスト使布工程を、同ホトレジスト使布放中に含有される船前の飽和雰囲気中で行う ことを特徴とするレジスト競の形成方法。
- (2) ホトレジストが、ボジ型であることを特徴と する特許請求の範囲第1項に記載のレジスト膜 の形成方法。
- (3) ホトレジストが、フェノールノポラック系の 樹脂をベースレジンにし、森解抑制剤として、 キノンジアジド系を用いたものであることを特 敬とする特許請求の範囲第1項に配数のレジスト級の形成方法。
- (4) ホトレジストの密刻が、エチレンセロソルプ アセテートであることを等位とする等許請求の 範囲第1項に記載のレジスト膜の形成方法。
- 3、発明の詳細な説明 産業上の利用分野

本発明は、半導体装置製造プロセスのホトレジスト他布工程において、放射状に発生するレジスト膜厚の酸小変化、いわゆるストリエージョンを防止する方法に関するものである。

従来例の構成とその問題点

半導体装置製造プロセスのホトレジスト銀布は、 通常、スピンナーを用い回転帆布により行われて いる。

従来、ホトレジスト使布を行うスピンナー部分は、カップ及び上部キャップ部が閉鎖システムで 排気ダクトにより常時排気されてかり、その排気 速度の酸妙な変化により、使布後のレジスト膜面 にストリエーションが発生しやすく、素子寸法の 酸細化に伴ない、このストリエーションによるレ ジスト膜厚に起因した素子寸法の酸小バランキが 素子特性パラツキの原因となり問題である。

発明の目的

本発明は、上記の問題点の解決を図ったもので · あり、ホトレジストの使布時に発生するレジスト 裏面のストリエーションを低減するレジスト膜の 形成寸法を提供するものである。

を囲の農材

本発明は、長約するに、ホトレジストの曲布を 同ホトレジスト曲布放中に含有される番別の飽和 雰囲気で行うもので、このことにより、同ホトレ ジスト中の着別の蒸発に伴ない発生するストリエ ーションを低減することが可能である。

・実施例の説明

本発明の詳細を実施例をもって説明する。

使用するホトレジストは、従来からポジ型のホトレジストとして良く用いられているフェノールノポラック系の樹脂をペースレジンにし、溶解抑制剤(感光基)にキノンジアジド系を用い、その溶剤としてエチレンセロソルプアセテートを用いたものである。

上記レジストを塗布するスピンナー部の観略断面図を第1図に示す。従来の物と同様、レジスト 検液を受けるカップ部1とレジストノズル2が取 りつけられた上部キャップ部3を有し、加えて、 上部キャップ部3にエチレンセロソルプアセテー

特局場60-226125(2)

発明の効果

本発明によると、ホトレジスト他布裏面のストリエーションを低減することができ、パターンの 像細化が進み、高製積組LSIの製造方法として、 特に好適であり、工業的価値が高い。

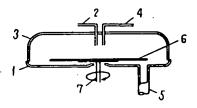
4、図面の簡単な説明

第1図は本発明で用いたレジストスピンナー部の概略図、第2図は本発明によるレジストのストリエーションによる膜厚変化と従来法を比較した 特性図である。

1 ……スピンナーカップ、2 ……レジストノズル、3 ……上部キャップ、4 ……格利の飽和蒸気供給ノズル、5 ……排気管、6 ……半導体基板、フ……スピンナー回転部。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

第 1 5



第 2 図

